В СПбО РАН состоялся VIII симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология»

15.04.2025

В историческом здании Императорской академии наук на Университетской набережной состоялся VIII симпозиум «Полупроводниковые лазеры: физика и технология», посвященный 95-летию со дня рождения Нобелевского лауреата **Ж.И. Алферова** и памяти выдающегося ученого-физика, внесшего огромный вклад в развитие физики полупроводников, академика **Р.А. Суриса**.

Идея создания научного мероприятия принадлежала академику **Ж.И. Алферову** (1930-2019), который являлся его бессменным председателем.

Организаторы – Санкт-Петербургское отделение РАН и Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН.

Участие приняли 140 ученых из ведущих научных учреждений РФ, занимающиеся фундаментальными и прикладными исследованиями в области получения и исследования светоизлучающих полупроводниковых соединений и структур, из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Воронежа, Саратова, Обнинска и др.

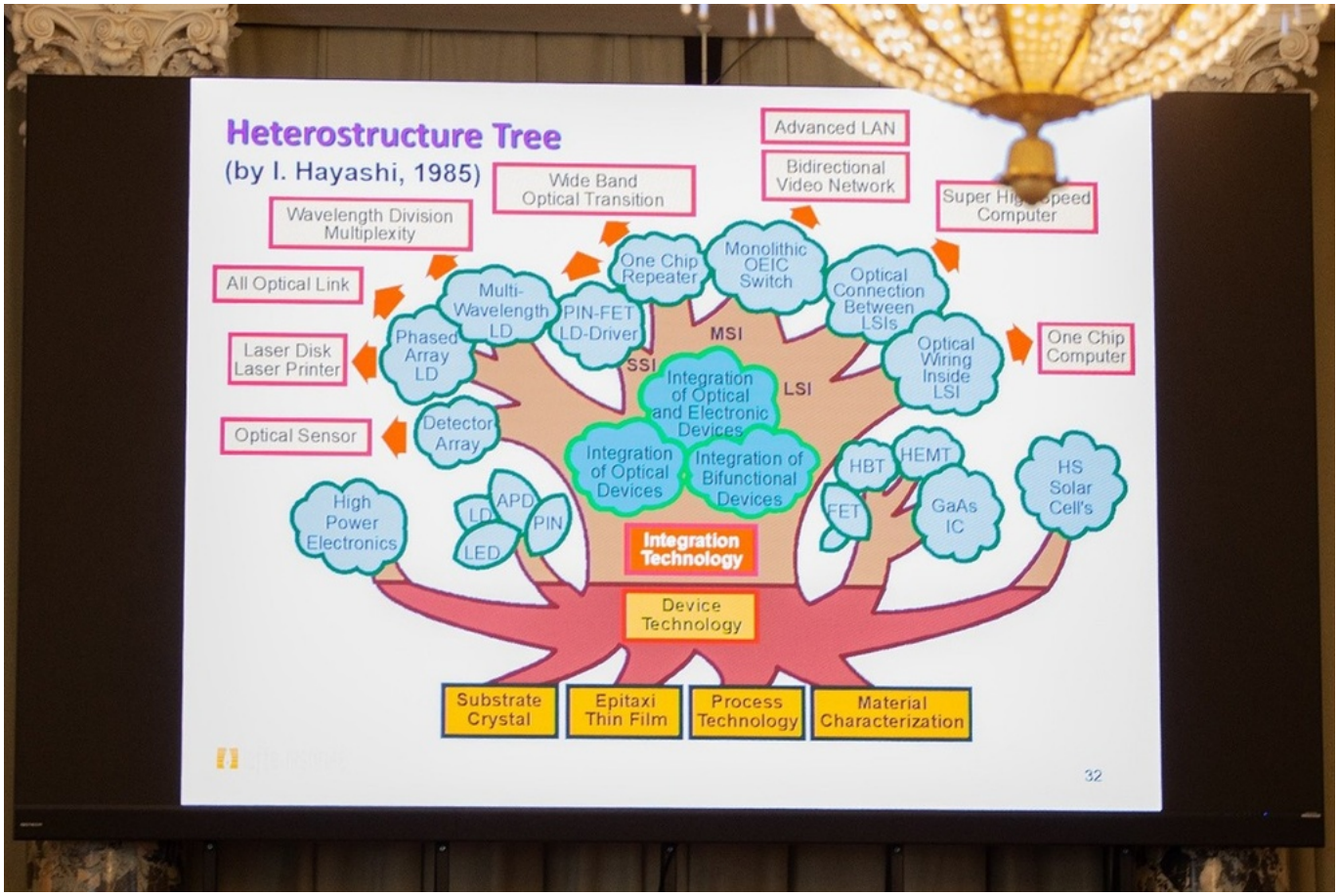
На пленарном заседании обсудили состояние и проблемы современной нано-оптоэлектроники, определили приоритетные направления развития полупроводниковых лазеров и перспективы их внедрения.

Ученые отметили важность фундаментальных и прикладных исследований светоизлучающих полупроводниковых соединений и структур с целью создания самых современных лазеров и обозначили необходимость активного взаимодействия науки, производства и бизнеса для дальнейшего развития российской физики полупроводников.

Одна из главных задач симпозиума – вовлечение в активную научную работу молодых ученых. За лучшие доклады исследователям до 36 лет были вручены премии: А.А. Разовой (ИФМ РАН, Нижний Новгород) за доклад «Микролазеры инфракрасного диапазона на основе гетероструктур с квантовыми ямами HgCdTe/CdHgTe» и П.С. Гавриной (ФТИ им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург) за «Влияние длины резонатора на уровень пиковой мощности лазеров-тиристоров при генерации импульсов длительностью единицы наносекунд».

300 Лет
Российская Академия Наук

Российская Академия Наук


Heterostructure Tree
(by I. Hayashi, 1985)
Wide Band Optical Transition
Advanced LAN
Bidirectional Video Network
Super High Speed Computer
Wavelength Division Multiplexity
All Optical Link
Laser Disk Laser Printer
Optical Sensor
One Chip Repeater
Monolithic OEIC Switch
Optical Connection Between LSIs
Optical Wiring Inside LSI
One Chip Computer
Multi-Wavelength LD
PIN-FET LD-Driver
Phased Array LD
Detector Array
MSI
SSI
LSI
Integration of Optical and Electronic Devices
Integration of Optical Devices
Integration of Bifunctional Devices
High Power Electronics
APD
LD
PIN
LED
HBT
HEMT
FET
GaAs IC
HS Solar Cell's
Integration Technology
Device Technology
Substrate Crystal
Epitaxi Thin Film
Process Technology
Material Characterization
32

Российская Академия Наук
Санкт-Петербургское отделение